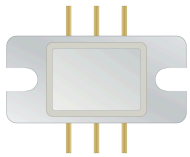
2000–8000 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 42.5 dBm (典型值)

LCI-PA-2000-8000-PS42p5T · 2000–8000 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT 42.5 dBm (典型值); 功率增益 15.5 dB (典型值); PAE 28 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW.



CMW010B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

封装外形尺寸: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2000	-	8000	MHz
饱和输出功率	-	40	42.5	-	dBm
功率增益	-	13	15.5	-	dB
功率附加效率	-	25	28	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	±1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	-2.4	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	18.03 × 8.7	mm
引脚总跨距	14.7	mm

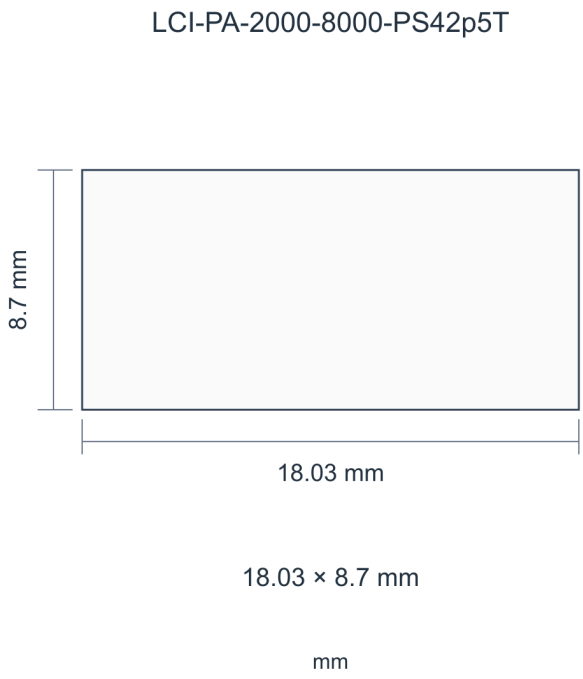
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

CMW010B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

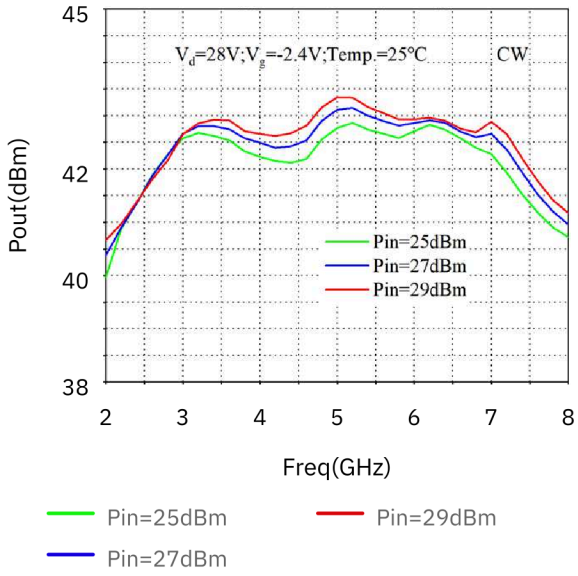
机械外形尺寸图

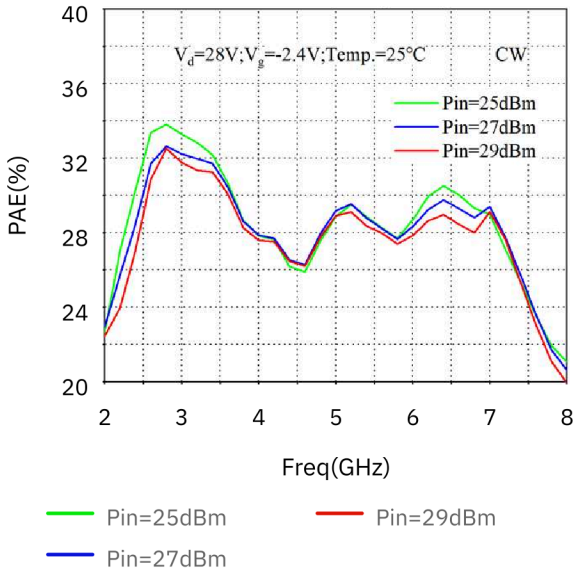
部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

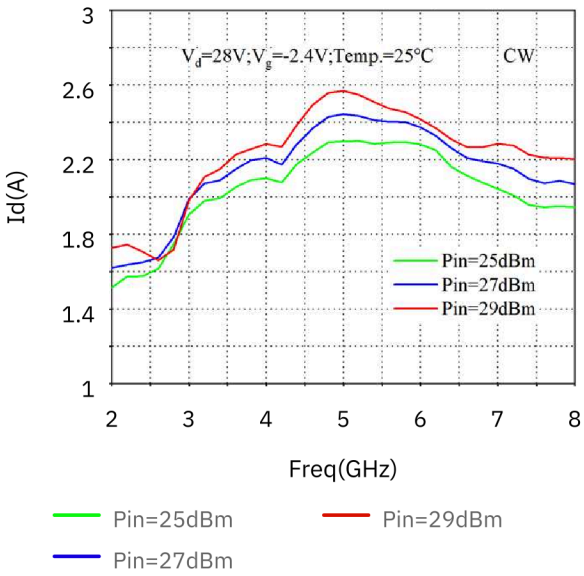


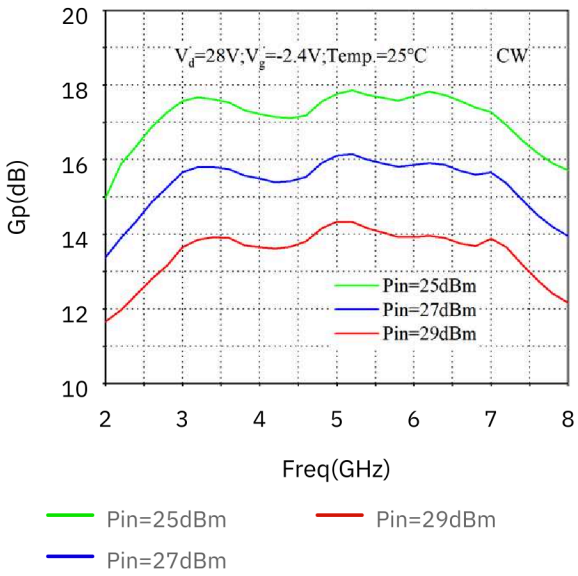
性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。









输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 25/27/29 dBm.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。